

R2A20112ASP

R03DS0047JJ0200

Rev.2.00

2015.09.25

臨界モードインターリーブ PFC コントロール IC

概要

R2A20112A は力率改善 (PFC) ブーストコンバータコントロール IC です。

R2A20112A の PFC 制御は臨界モードのゼロカレントスイッチングによる高効率・低スイッチングノイズを実現します。インターリーブ機能は、2 統のブーストコンバータを 180°位相シフトさせることにより、従来、連続モードが適した電力範囲もカバーし、高効率・低スイッチングノイズと共に入出力のリプル電流を低減します。

R2A20112A はソフトスタート、フィードバックループ断線検出、2 モード過電圧保護、過電流保護、昇圧ダイオードショート時の過電流 ON/OFF タイマ保護、ZCD 信号オープン検出機能を内蔵し、少ない外付け部品で高信頼度の電源システムを構成できます。

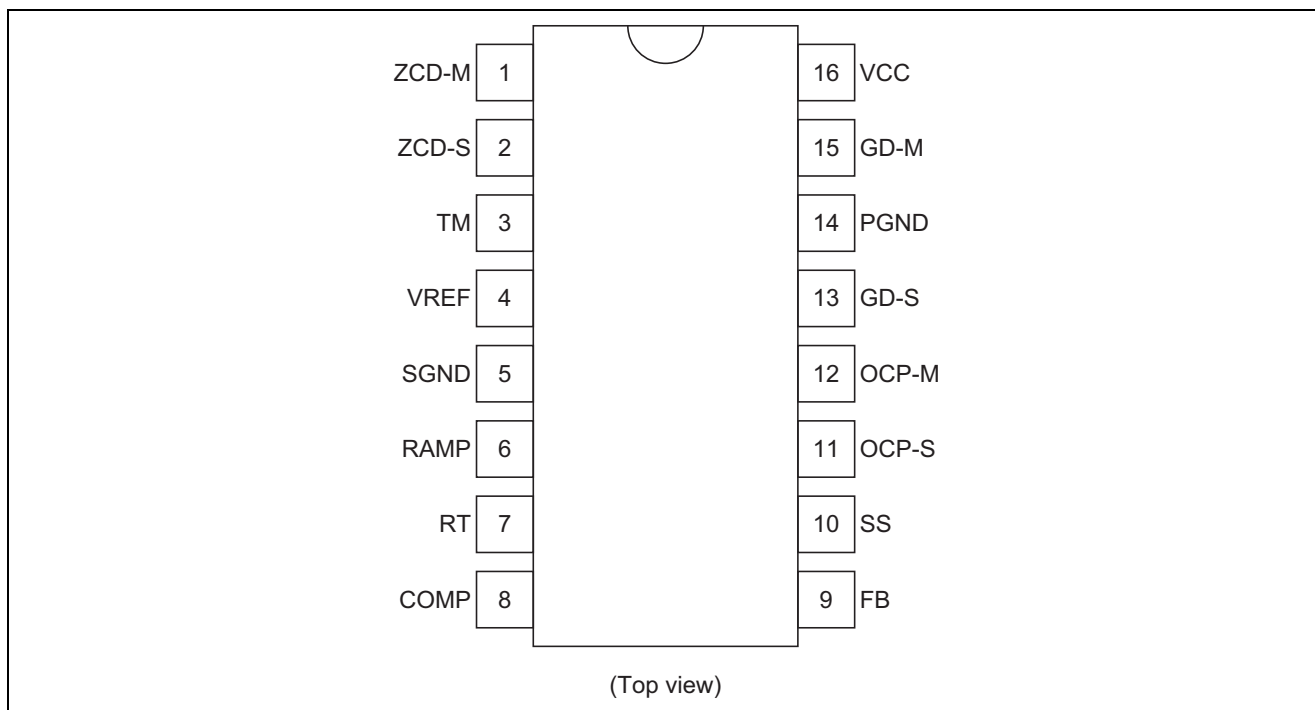
特長

- 絶対最大定格
 - 電源電圧 V_{cc} : 24V
 - 接合温度 T_j : -40 ~ +150°C
- 電気的特性
 - VREF 出力電圧 V_{ref} : 5.0V ± 1.5%
 - UVLO 動作開始電圧 V_{uvlh} : 10.5V ± 0.7V
 - UVLO 動作停止電圧 V_{uvll} : 9.3V ± 0.5V
 - UVLO ヒステリシス電圧 Hys_{uvl} : 1.2V ± 0.5V
- 機能
 - 臨界モードブーストコンバータコントロール
 - インターリーブコントロール
 - エラーアンプの基準電圧に対してのソフトスタート機能
 - 2 モード過電圧保護
 - モード 1: 負荷急変時の電圧上昇を防止する、ダイナミック OVP
 - モード 2: 定常字の過電圧を防止する、スタティック OVP
 - PFC 出力電圧 ダイナミック電圧降下保護 (DUVP)
 - フィードバックループ断線検出
 - マスタ、スレーブ独立過電流保護
 - 280μs リスタートタイマ
 - スレーブ ZCD 信号オープン検出
 - 昇圧ダイオードショート時の過電流 ON/OFF タイマ保護機能
- パッケージ
 - Pb フリー SOP-16

発注情報

発注型名	パッケージ名称	パッケージコード	パッケージ略称	テーピング略称 (数量)
R2A20112ASPW0	FP-16DAV	PRSP0016DH-B	SP	W (2,000 個/リール)

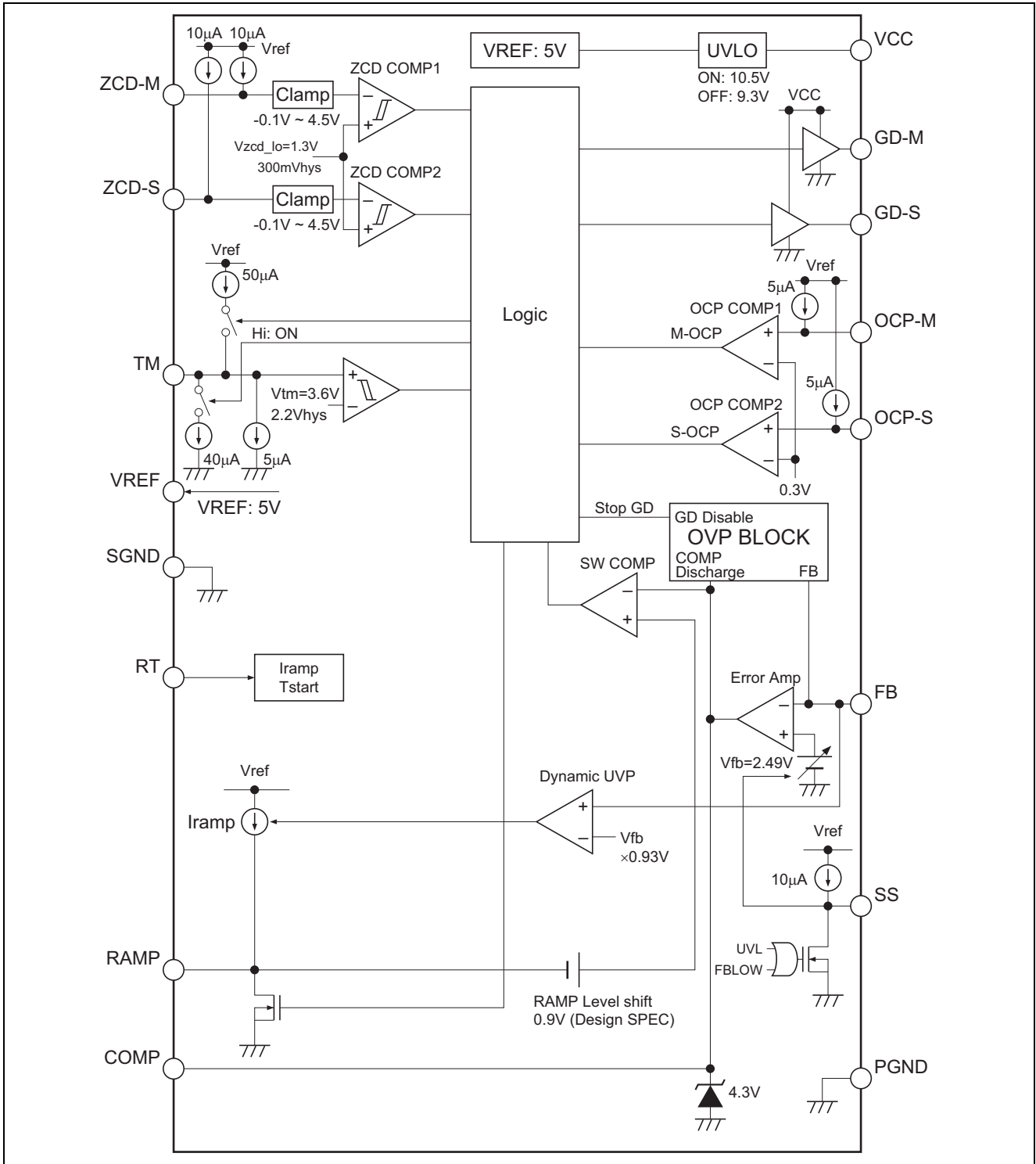
ピン配置



ピン機能

ピン No.	ピン名	機能
1	ZCD-M	マスタコンバータゼロ電流検出入力端子
2	ZCD-S	スレーブコンバータゼロ電流検出入力端子
3	TM	過電流 ON/OFF タイマ保護端子
4	VREF	基準電圧出力端子
5	SGND	小信号回路用接地端子
6	RAMP	RAMP 充電電流調節機能設定端子
7	RT	クロック周波数設定用タイミング抵抗接続端子
8	COMP	エラーアンプ出力端子
9	FB	エラーアンプ入力端子
10	SS	ソフトスタート時間設定用容量接続端子
11	OCP-S	スレーブコンバータ用過電流検出入力端子
12	OCP-M	マスタコンバータ用過電流検出入力端子
13	GD-S	スレーブコンバータ用パワー-MOSFET ゲート駆動出力端子
14	PGND	出力段回路用接地端子
15	GD-M	マスタコンバータ用パワー-MOSFET ゲート駆動出力端子
16	VCC	電源電圧入力端子

ブロックダイアグラム



絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	定格値	単位	注
電源電圧	VCC	-0.3 ~ +24	V	
GD 端子ピーク電流	l _{pk-gd}	-300 +1200	mA	3
GD 端子 DC 電流	l _{dc-gd}	-15 +60	mA	
ZCD 端子電流	l _{zcd}	+3 -3	mA	
RT 端子電流	l _{rt}	-200	μA	4
Vref 端子電流	l _{ref}	-5	mA	
Vref 端子負荷容量接続可能範囲	C _{ref min}	1000	pF	
	C _{ref max}	1	μF	
COMP 端子電流	l _{comp}	±1	mA	
端子電圧	V _{t-group1}	-0.3 ~ V _{cc}	V	5
	V _{t-group2}	-0.3 ~ V _{ref}	V	6
Vref 端子電圧	V _{t-ref}	-0.3 ~ V _{ref} + 0.3	V	
OCP 端子電圧	V _{t-ocp}	*-1 ~ V _{ref}	V	7
許容消費電力	P _t	1	W	8
動作周囲温度	T _{a-opr}	-40 ~ +125	°C	
接合温度	T _j	-40 ~ +150	°C	9
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C	

- 【注】
1. 定格電圧は、PGND 端子を基準とします。
 2. 定格電流は、IC に流れ込む方向を(+)、流れ出す方向を(-)とします。
 3. 容量性負荷を駆動する際の過渡的な電流です。
 4. RT 端子抵抗値は、対 GND に 33kΩの固定値です。
 5. 以下の端子についての定格電圧です。
なし
 6. 以下の端子についての定格電圧です。
FB, SS, RAMP, TM
 7. 負電圧の値はピーク電圧です。負の DC 電圧を印加しないでください。
 8. $\theta_{ja} = 120^{\circ}\text{C/W}$
この値は 40 × 40 (厚み: 1.6mm) [mm²]、配線密度 10%のガラスエポキシ基板に実装時のものです。
 9. 絶対最大定格を超えるストレスは製品に致命的なダメージを与えることがあります。
これはストレスの定格のみを示しており、推奨する動作周囲温度範囲を超える状態での本製品の機能動作は含まれていません。
絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。

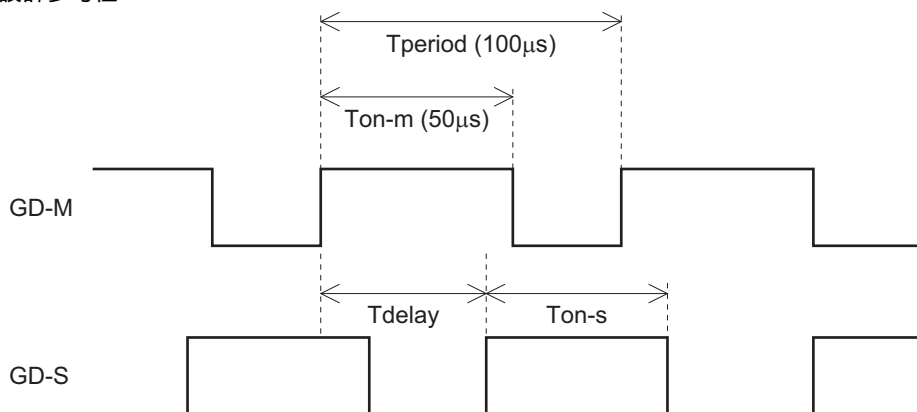
電気的特性

(Ta = 25°C, VCC = 12 V, RT = 33 kΩ, RAMP = 820 pF, TM = 2.2 μF, SS = 1.0 μF, OCP = GND)

Item		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
Supply	UVLO turn-on threshold	Vuvlh	9.8	10.5	11.2	V	
	UVLO turn-off threshold	Vuvll	8.8	9.3	9.8	V	
	UVLO hysteresis	Hysuwl	0.7	1.2	1.7	V	
	Standby current	Istby	—	85	170	μA	VCC = 8.9 V
	Operating current	Icc	—	4.2	6.3	mA	
VREF	Output voltage	Vref	4.925	5.00	5.075	V	Isource = -1 mA
	Line regulation	Vref-line	—	5	20	mV	Isource = -1 mA Vcc = 10 V to 24 V
	Load regulation	Vref-load	—	5	20	mV	Isource = -1 mA to -5 mA
	Temperature stability	dVref	—	±80	—	ppm/°C	Ta = -40 to +125°C *1
Error amplifier	Feedback voltage	Vfb	2.452	2.490	2.528	V	FB-COMP short
	Input bias current	Ifb	-0.5	-0.3	-0.1	μA	Measured pin: FB FB = 3 V *1
	Open loop gain	Av	—	60	—	dB	*1
	Upper clamp voltage	Vclamp-comp	4.2	4.3	4.4	V	FB = 2.0 V
	Low voltage	VI-comp	—	0.1	0.3	V	FB = 3.0 V
	Source current	Isrc-comp	—	-120	—	μA	FB = 1.5 V COMP = 2.5 V *1
	Sink current	Isrc-comp	—	330	—	μA	FB = 3.5 V COMP = 2.5 V
Ramp	RAMP charge current at DUVP disable condition	Ic-ramp1	-60	-50	-40	μA	FB = 2.4 V
	RAMP charge current at DUVP enable condition	Ic-ramp2	-32	-25	-18	μA	FB = 2 V
	RAMP discharge current	Id-ramp	7	15	29	mA	RAMP = 1 V
	Low voltage	VI-ramp	—	17	200	mV	Isrc = 100 μA
Slave control	Phase delay	Phase	160	180	200	deg	FB = 2.5 V, COMP = 2 V *1,2
	On time ratio	Ton-ratio	0	—	5	%	

【注】 1. 設計参考値

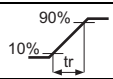
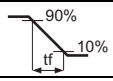
2.



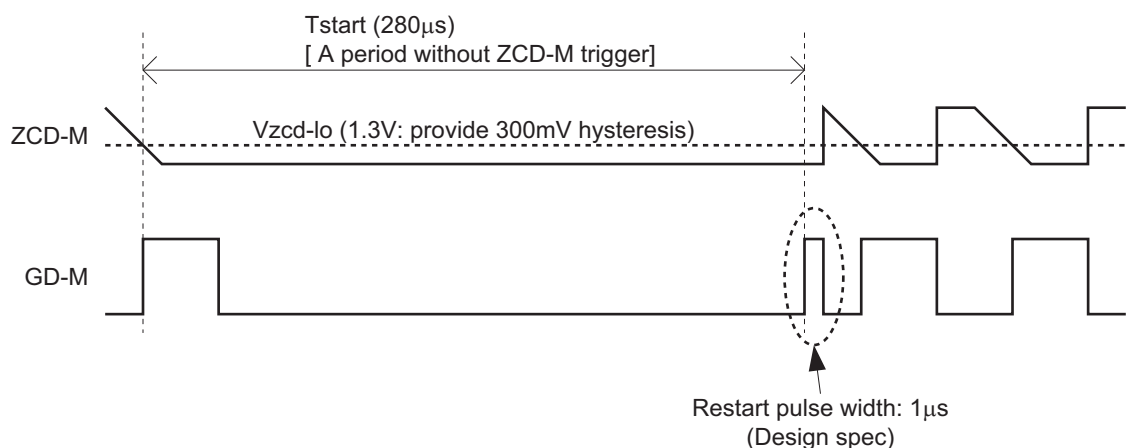
$$\text{Phase} = \frac{T_{\text{delay}}}{T_{\text{period}}} \times 360 \text{ [deg]}$$

$$\text{Ton-ratio} = \left(1 - \frac{T_{\text{on-s}}}{T_{\text{on-m}}}\right) \times 100 \text{ [%]}$$

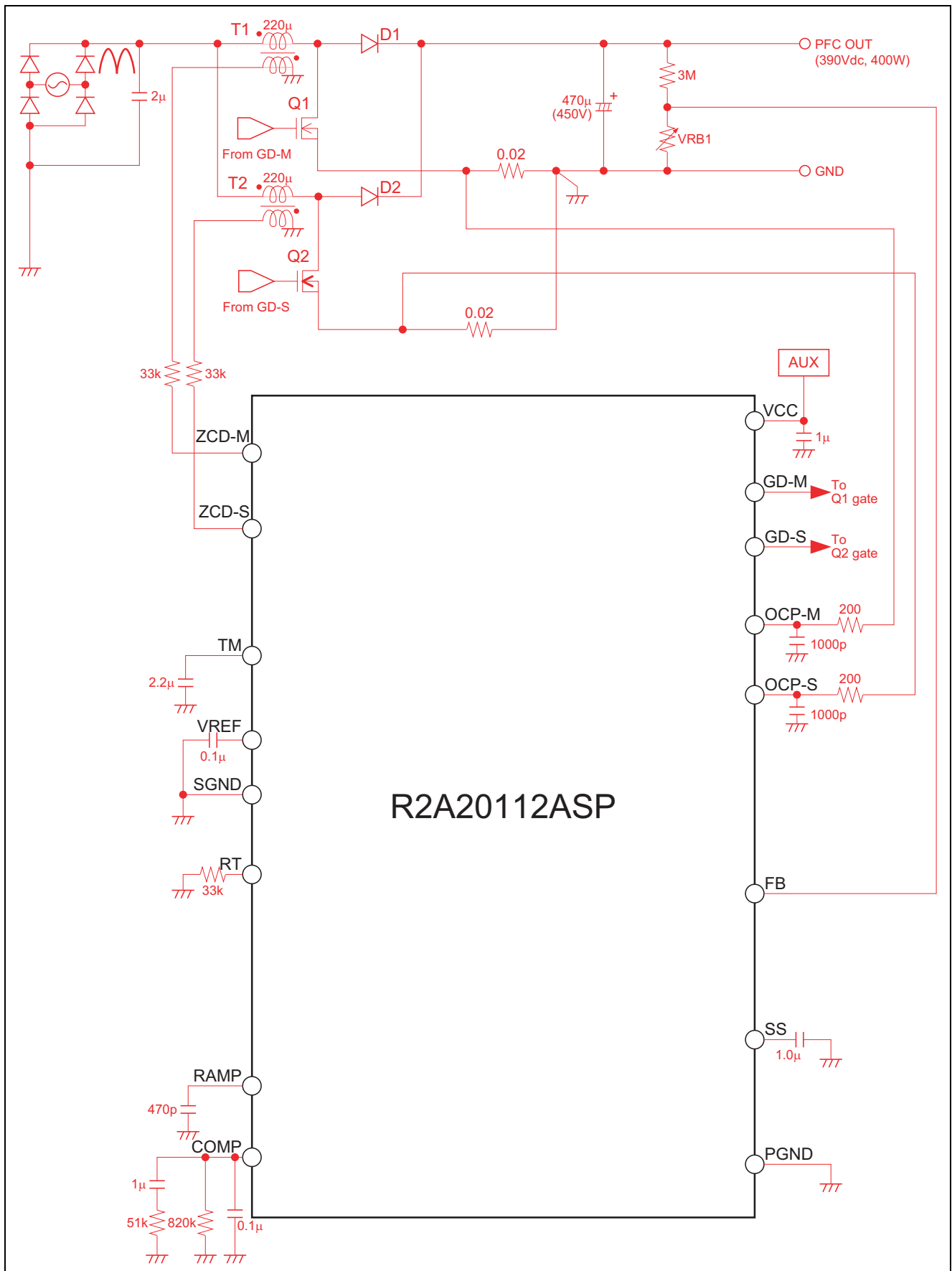
(Ta = 25°C, VCC = 12 V, RT = 33 kΩ, RAMP = 820 pF, TM = 2.2 μF, SS = 1.0 μF, OCP = GND)

Item		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
Gate drive (GD-M & GD-S)	Gate drive rise time	tr-gd	—	20	100	ns	FB-COMP short CL = 100 pF 
	Gate drive fall time	tf-gd	—	5	30	ns	FB-COMP short CL = 100 pF 
	Gate drive low voltage	Vol1-gd	—	0.02	0.1	V	Isink = 2 mA
		Vol2-gd	—	0.01	0.2	V	Isink = 1 mA, VCC = 5 V
Gate drive high voltage	Voh-gd	11.5	11.9	—	V	Isource = -2 mA *1	
Over current protection (OCP-M & OCP-S)	OCP threshold voltage	Vocp	0.27	0.30	0.33	V	
	OCP source current	Iocp	-10	-5	-2.5	μA	OCP = 0 V
ON/OFF timer protection for Boost diode short	ON/OFF timer threshold voltage	Vtm	3.52	3.6	3.68	V	
	ON/OFF timer hysteresis	Hys-tm	2.1	2.2	2.3	V	
	Charge current	Isrc-tm	-54	-45	-36	μA	TM = 2 V, OCP-M = 1 V
	Discharge current at TM disable condition	I _{snk-tm1}	36	45	54	μA	TM = 2 V
	Discharge current at TM enable condition	I _{snk-tm2}	4.2	5	5.8	μA	TM = 5 V to 2 V
PFC output abnormality protection	Dynamic OVP threshold voltage	Vdovp	Vfb× 1.035	Vfb× 1.050	Vfb× 1.065	V	COMP = 2.5 V
	Static OVP threshold voltage	Vsovp	Vfb× 1.075	Vfb× 1.090	Vfb× 1.105	V	COMP = 2.5 V
	Static OVP hysteresis	Hys-sovp	50	100	150	mV	COMP = 2.5 V
	Dynamic UVP threshold voltage	Vduvp	—	Vfb× 0.930	Vfb× 0.950	V	COMP = 2.5 V *1
	FB low detect threshold voltage	Vfblow	0.45	0.50	0.55	V	COMP = 2.5 V
	FB low detect hysteresis	Hysfblow	0.16	0.20	0.24	V	COMP = 2.5 V
Zero current detector (ZCD-M & ZCD-S)	Upper clamp voltage	Vzcdh	4.0	4.5	5.0	V	Isource = -3 mA
	Lower clamp voltage	Vzcdl	-0.5	-0.1	0.4	V	Isink = 3 mA
	ZCD low threshold voltage	Vzcd-lo	0.9	1.3	1.6	V	*1
	ZCD hysteresis	Hyszcd	130	300	410	mV	*1
	Input bias current	Izcd	-14	-10	-6	μA	1.2 V < Vzcd < 2.5 V
ZCD-S open detector	Slave ZCD open detect delay time	tzcds	—	100	—	ms	ZCD-S: OPEN Gate drive 10 kHz *1
Soft start	Charge current	Ic-ss	-14	-10	-6	μA	SS = 3 V, FB = 1 V
Restart	Restart time delay	Tstart	210	280	350	μs	ZCD-M = 10 kΩ to GND ZCD-S = 10 kΩ to GND *2

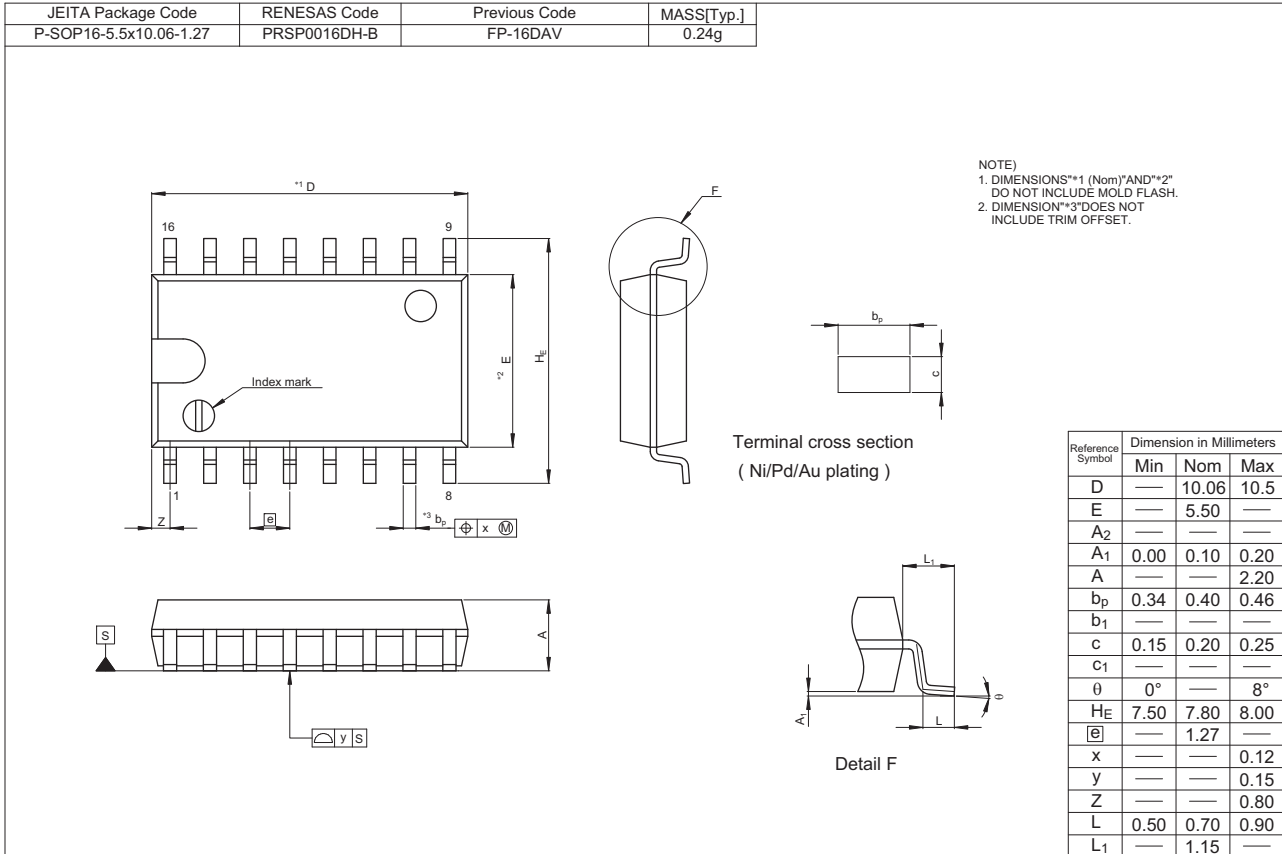
- 【注】 1. 設計參考值
2.



周边回路例



外形寸法図



ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、
防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍用用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

営業お問い合わせ窓口

<http://www.renesas.com>

営業お問い合わせ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレスト)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問い合わせ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>